

(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(51) Int. Cl.⁵
H01L 27/82

(11) 공개번호 특1991-0013565
(43) 공개일자 1991년08월08일

(21) 출원번호	특1990-0021727
(22) 출원일자	1990년12월26일
(30) 우선권주장	1-342408 1989년12월28일 일본(JP)
(71) 출원인	가부시키가이샤 도시바 아오이 죠이치
(72) 발명자	일본국 가나가와현 가와사키시 사이와이구 호리가와정 72번지 가츠마타 야스히로
(74) 대리인	일본국 가나가와현 가와사키시 사이와이구 고우가이도시바정 1번지 가부시 키가이샤 도시바 다마가와 공장내 김윤배, 이범일

심사청구 : 있음

(54) 래터럴형 반도체장치

요약

내용 없음.

대표도

도3

명세서

[발명의 명칭]

래터럴형 반도체장치

[도면의 간단한 설명]

제3도는 본 발명에 따른 래터럴형 트랜지스터의 단면도이다.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1

제1도전형을 나타내는 반도체기판(20)과, 이 반도체기판에 형성되는 반대도전형의 매립영역(21), 상기 반도체기판에 퇴적하는 매립영역보다 저농도인 반대도전형 반도체층(22), 이 반대도전형 반도체층을 둘러싸도록 형성하는 분리용 절연물층(23), 이 절연물층으로부터 노출되는 반대도전형 반도체층 표면을 향해 연장되며 두께가 분리용 절연물층보다 얇은 제1환상 절연물층(26), 그 내부에 노출되는 반대도전형 반도체층에 형성하며 두께가 제1환상 절연물층과 동일한 제2절연물층(27), 제1 및 제2 절연물층의 단부에 인접되게 형성하는 제1도전형의 제1 및 제2 환상 불순물영역(24,25)을 구비하여 구성된 것을 특징으로 하는 래터럴형 반도체장치.

※ 참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

도면

도면3

